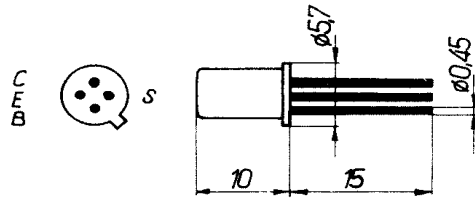


Germanium-pnp-Legierungs-Diffusions-Transistor der Bauform A 4/15 — 4b nach TGL 11 811 für Verstärkerstufen bei 37 MHz.



Masse ca. 0,6 g

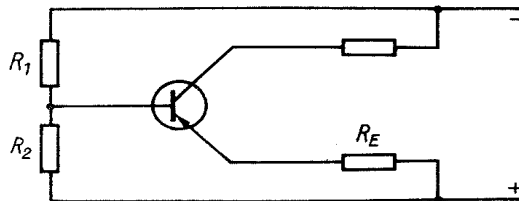
Wärmewiderstand

$R_{thja} \leq 0,6 \text{ grad/mW}$

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

| | | |
|----------------------------|-----------------|---|
| Kollektor-Basis-Spannung | $-U_{CB0}$ | $= 25 \text{ V}$ |
| Kollektor-Emitter-Spannung | $-U_{CEr}^{1)}$ | $= 20 \text{ V}$ |
| Emitter-Basis-Spannung | $-U_{EB0}$ | $= 0,5 \text{ V}$ |
| Gesamtverlustleistung | P_v | $= 80 \text{ mW}$ bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ |
| Kollektorstrom | $-I_c$ | $= 10 \text{ mA}$ |
| Emitterstrom | I_E | $= 11 \text{ mA}$ |
| Basisstrom | $-I_B$ | $= 1 \text{ mA}$ |
| Sperrschichttemperatur | ϑ_j | $= 75^\circ\text{C}$ |
| Betriebstemperaturbereich | | $-25^\circ\text{C bis } +65^\circ\text{C}$ |

1) bei $R_B/R_E \leq 100$ mit $R_B = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$



Statische Kennwerte

| | | Min. | Typ | Max. |
|---------------------------------|------------|------|-----|-------------------|
| Kollektor-Basis-Reststrom | $-I_{CB0}$ | | | $7,5 \mu\text{A}$ |
| $-U_{CB} = 6 \text{ V}$ | | | | |
| Kollektor-Basis-Reststrom | $-I_{CB0}$ | | | $100 \mu\text{A}$ |
| $-U_{CB} = 25 \text{ V}$ | | | | |
| Emitter-Basis-Reststrom | $-I_{EB0}$ | | | $100 \mu\text{A}$ |
| $-U_{EB} = 0,5 \text{ V}$ | | | | |
| Kollektor-Basis-Stromverhältnis | h_{21E} | 40 | | |
| $-U_{CE} = 6 \text{ V}$ | | | | |
| $-I_c = 1 \text{ mA}$ | | | | |

Dynamische Kennwerte

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Übergangsfrequenz | f_T | 100 MHz | | |
| $-U_{CE} = 10 \text{ V}$ | | | | |
| $-I_c = 3 \text{ mA}$ | | | | |
| $f = 100 \text{ MHz}$ | | | | |
| Rückwirkungszeitkonstante | $\frac{ h_{12b} }{\omega}$ | | | 24 ps |
| $-U_{CB} = 10 \text{ V}$ | | | | |
| $-I_c = 3 \text{ mA}$ | | | | |
| $f = 30 \text{ MHz}$ | | | | |
| Vierpolparameter | g_{11e} | 5 mS | 11 mS | 25 mS |
| | C_{11e} | 12 pF | 30 pF | 80 pF |
| | $ y_{21e} $ | 40 mS | 60 mS | |
| | g_{22e} | 83 μS | 160 μS | 360 μS |
| | C_{22e} | 1,5 pF | 2,5 pF | 4,5 pF |
| Rückwirkungskapazität | $-C_{12e}$ | 0,55 pF | | 1,2 pF |
| $-U_{CE} = 6 \text{ V}$ | | | | |
| $-I_c = 1 \text{ mA}$ | | | | |
| $f = 10 \text{ MHz}$ | | | | |

Bestellbeispiel für einen Transistor

Transistor GF 128

